

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0201U006012

Державний реєстраційний номер: 0197U003202

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 18-06-2001

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Дослідження квантово-хімічних процесів каталізу в структурах газових сенсорів на основі контактів метал-напівпровідник.

Початок етапу: 01.1996

Закінчення етапу: 12.2000

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, кафедра загальної і молекулярної генетики

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет міністрів

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 2661468

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 52 – договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією, концерном тощо)

Напрямок фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Дослідження квантово – хімічних процесів каталізу в структурах газових сенсорів на основі контактів метал – напівпровідник.

Назва роботи англійською:

The investigation of the quantum-chemical processes of the catalysis in the structures of the gas sensors basic on contacts metal – semiconductor.

Реферат українською:

В роботі було досліджено чутливість поверхнево-бар'єрних структур на основі кремнію з надтонкими плівками титану та нікелю до аміаку, встановлено основні механізми газової чутливості таких структур. Отримані результати дозволили встановити фізичні методи аналізу впливу газового середовища на властивості гетерофазних поверхнево-бар'єрних структур.

Реферат англійською:

The sensitivity of surface-barrier structures on the basis of silicon with superthin films of a titanium and nickel to the ammonia was investigated. The main mechanism of the gas sensitivity was established. The obtained outcome have allowed to offer physical methods to analysis of influence of gas medium on properties of heterophase surface – barrier structures.5635

Індекс УДК: 537.311.31, 537.311.33;539.194

Коди тематичних рубрик: 29.19.27

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Ільченко В.В.

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

Bomk O.I., Il'chenko L.G., Il'chenko V.V., Kuznetsov G.V., Pinchuk A.M., Pinchuk V.M., Strickha V.I. Cluster model of gas sensitivity nanosructural sensor of ammonia // Fourth International conference on Nanostructured Materials. Book of abstract. -Stockholm (Sweden). -1998. -P. 352.;Бомк О.Й., Ільченко Л.Г., Ільченко В.В., Кузнецов Г.В., Пінчук О.М., Пінчук В.М., Стріха В.І. Про природу чутливості до аміаку газових сенсорів на основі структур надтонка титанова плівка - кремній // Український фізичний журнал. -1999. -Т. 44. -№6. -С. 759-763.;Bomk O.I., Il'chenko L.G., Il'chenko V.V., Pinchuk A.M., Pinchuk V.M., Kuznetsov G.V., Strikha V.I. About the gas sensitivity of contacts metal - silicon with the superthin nickel and titanium films to the ammonia environment // Sensors and actuators B. -2000. -№ 62.-P. 131-135.

Х. Заключение відомості

Керівник юридичної особи

Гондюл В.П.

Перелік осіб-виконавців

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Телефон

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

